発光中心添加 Ca₂B₂O₅ 熱蛍光体における LET 特性の制御

Control of LET dependence of thermoluminescence properties of doped $Ca_2B_2O_5$

静大電子研¹,東北大院工²,QST³

°越水 正典¹, 小宮 基², 古場 裕介³, 藤本 裕², 浅井 圭介²

Shizuoka Univ. ¹, Tohoku Univ. ², QST³ ^oMasanori Koshimizu¹, Hajime Komiya², Yusuke Koba³, Yutaka Fujimoto², Keisuke Asai²

E-mail: koshimizu.masanori@shizuoka.ac.jp

【緒言】蓄積型線量計を用いた重粒子線の線量測定において、その応答の線エネルギー付与 (LET) に対する顕著な依存性は、線量の正確な測定を困難とする。この LET 依存性について、市販の熱 蛍光体に対する解析例は数多い。一方で、材料開発者がこの LET 依存性の解明ないし制御に取り 組む事例というのはあまり見られない。材料開発の観点からは、例えば、同一ホストに対してドーパントの種類や濃度を変化させた材料を開発し、その LET 依存性を系統的に調査することが可能である。本講演では、我々が熱中性子測定用の熱蛍光体として開発した、発光中心添加 $Ca_2B_2O_5$ セラミックスに対し、LET 依存性の制御に成功した事例を紹介する。

【実験方法】

【結果と考察】既往の希土類添加 Ca2B2O5 セラミックスの熱蛍光特性の LET 依存性 の我々の研究では、

- ① 正孔捕獲機能を有する添加イオン+ 電荷補償欠陥 (Ce 添加 Ca₂B₂O₅ が該当)
- ② 正孔捕獲機能を有する添加イオン (電荷補償なし) (Eu 添加 $Sr_2B_2O_5$ が該当)
- ③ 正孔捕獲機能を有しない添加イオン +電荷補償欠陥 (Dy 添加 Ca₂B₂O₅が該当) というケースを対象として研究をこれま で進めてきた。これらの分類での LET 依 存性の急峻さは、①>②>③となることか ら、少なくともこれまでの研究事例では、 正孔捕獲機能を有する発光中心の添加や、 電荷補償欠陥の生成は、LET 依存性を急峻 にするものと結論づけられる。これらの結 果からの自然な推察として、
- ④ 正孔捕獲機能を有しない添加イオン (電荷補償なし)

のケースにおいて最も LET 依存性が緩やかであると予想される。これを実現するものとして、Sn 添加 $Ca_2B_2O_5$ セラミックスとして実現し、その LET 依存性を解析した結果として、グローカーブを Fig. 1 に、LET に依存した熱蛍光強度を Fig. 2 に示す。① \sim ③のケースと比較して緩やかな LET 依存性が達成され、仮説が実証された。

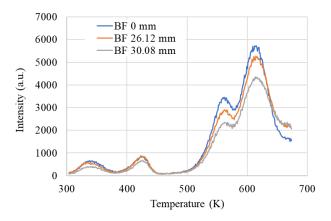


Fig. 1. TL glow curves of Sn-doped $Ca_2B_2O_5$ ceramics after irradiation of 135-MeV/n carbon with different thicknesses of binary filter (BF).

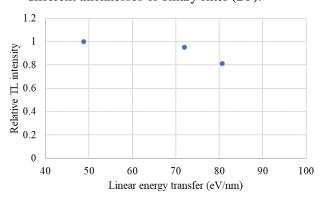


Fig. 2. LET dependence of TL intensity of Sn-doped Ca₂B₂O₅ ceramics.